

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第1区分

【発行日】平成21年9月24日(2009.9.24)

【公開番号】特開2008-218096(P2008-218096A)

【公開日】平成20年9月18日(2008.9.18)

【年通号数】公開・登録公報2008-037

【出願番号】特願2007-51593(P2007-51593)

【国際特許分類】

H 01 B	5/14	(2006.01)
G 03 C	1/00	(2006.01)
H 05 K	1/09	(2006.01)
H 01 B	13/00	(2006.01)
B 32 B	9/04	(2006.01)
H 05 K	3/10	(2006.01)

【F I】

H 01 B	5/14	A
G 03 C	1/00	Z
H 05 K	1/09	A
H 01 B	5/14	B
H 01 B	13/00	5 0 3 D
B 32 B	9/04	
H 05 K	3/10	C

【手続補正書】

【提出日】平成21年8月10日(2009.8.10)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

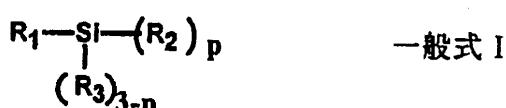
【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

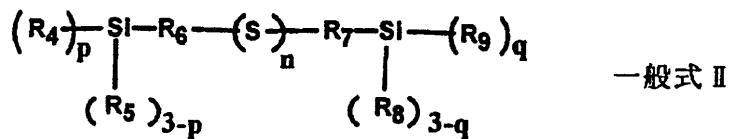
支持体上に少なくとも物理現像核層とハロゲン化銀乳剤層をこの順に有する導電性材料前駆体において、物理現像核層、もしくはそれに接する層が下記一般式I、若しくはIIで示されるシランカップリング剤を含有することを特徴とする導電性材料前駆体。

【化1】



(一般式I中、R₁は1級アミノ基、2級アミノ基、ウレイド基、アミジノ基、グアニジノ基、ウレイレン基、イソウレイド基、チオウレイド基、チオウレイレン基、イソチオウレイレン基、カルバゾイル基、チオカルバゾイル基、セミカルバジド基、チオセミカルバジド基、カルバゾノ基、カルボノヒドラジド基、チオカルボノヒドラジド基、セミカルバゾノ基、チオセミカルバゾノ基、チオカルバゾノ基、カルボジアゾノ基、チオカルボジアゾノ基、メルカプト基、含窒素複素環基から選ばれる少なくとも1つの官能基を有する基を表す。R₂はアルコキシ基又はハロゲン原子からなる基を表し、R₃はメチル基、もしくはエチル基を表し、pは1、2又は3を表す。)

【化2】



(一般式II中、R₄及びR₉はそれぞれアルコキシ基又はハロゲン原子からなる基を表し、R₅及びR₈はそれぞれメチル基、もしくはエチル基を表し、R₆及びR₇は炭素数1～6の飽和炭化水素基を表し、nは2～6の自然数であり、p、qはそれぞれ1、2、又は3を表す。)

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】発明の名称

【補正方法】変更

【補正の内容】

【発明の名称】導電性材料前駆体